Тема 603 «Полупроводниковые гетероструктуры для наноэлектроники и нанофотоники»

Аннотация

Целью данного конкурса является поддержка междисциплинарных научных исследований, направленных на решение фундаментальных проблем в области создания полупроводниковых гетерструктур, протекающих в них процессов и целенаправленное исследование управление их свойствами с целью оптимизации характеристик СУЩЕСТВУЮЩИХ И разработки принципиально новых устройств наноэлектроники и нанофотоники, реализующих свою функциональность счет особенностей зонной структуры, эффектов размерного квантования, явлений, возникающих на гетерограницах. Ожидаемым консолидированным прорывным результатом работ по данному конкурсу будут новые знания и технологические приемы, способствующие развитию компонентной базы полупроводниковой наноэлектроники и фотоники.

Рубрикатор

- **603.1.** Новые полупроводниковые материалы и гетероструктуры пониженной размерности
- 603.2. Наногетероструктуры для устройств СВЧ и ТГц электроники.
- **603.3.** Наногетероструктуры для быстродействующих лазеров, микролазеров, квантво-каскадных лазеров, источников одиночных фотонов
- **603.4.** Наногетероструктуры для фотоэлектрических преобразователей с улучшенной эффективностью и/или расширенным спектральным диапазоном, возобновляемых источников энергии и фотоприемников.
- **603.5.** Фундаментальные проблемы биосенсоров на основе наногетероструктур, а также взаимодействия полупроводниковых наноструктур с биологическими системами.
- **603.6.** Наногетероструктуры, формируемых на инородных подложках, в том числе АЗВ5 на кремнии
- **603.7.** Широкозонные полупроводниковые материалы для высокотемпературной и силовой электроники, излучателей белого света, RGB и УФ диапазонов